


	<h2 style="color: red;">FDB8870_F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDB8870_F085
	<b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 21A TO-263AB
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB8870_F085.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB8870_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 21A TO-263AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5200pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	132nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Ta), 160A (Tc)

FDB8870\_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8870\_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8870\_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDB8870\_F085 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>FDB8870</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8874</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8860_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB8860_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDB8870</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A TO-263AB</p>
 <p><b>FDB8878</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8860-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8870-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8876</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB8870_F085 Fairchild/ON Semiconductor	FDB8870_F085 Datenblatt	FDB8870_F085-Datenblätter	FDB8870_F085 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB8870_F085
FDB8870_F085 Electronic	FDB8870_F085-Komponenten	FDB8870_F085-Verteiler	FDB8870_F085-Bild	FDB8870_F085-Teil
FDB8870_F085 Preis	FDB8870_F085 Hersteller	FDB8870_F085 Bild	FDB8870_F085 Aktie	FDB8870_F085 Inventar
FDB8870_F085 Neu	FDB8870_F085 Original	FDB8870_F085 garantiert	FDB8870_F085 RFQ	FDB8870_F085 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited